



华晶分立器件

3DG2383

高频放大环境额定双极型晶体管

1 概述与特点

3DG2383 硅 NPN 型高频高压小功率晶体管，适用于一般高频放大电路。其特点如下：

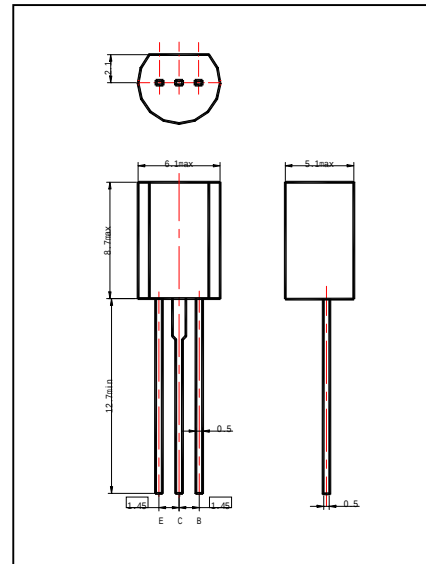
- 电流容量大
- 饱和压降低
- 击穿电压高
- 封装形式：TO-92MOD

2 电特性

2.1 极限值

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-发射极电压	V_{CE0}	160	V
集电极-基 极电压	V_{CB0}	160	V
发射极-基 极电压	V_{EB0}	6	V
集电极电流	I_C	1.0	A
耗散功率($T_a=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	0.9	W
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	$-55\sim 150$	$^{\circ}\text{C}$



2.2 电参数

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=150\text{V}, I_E=0$			1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$			1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=200\text{mA}$	R	60	120	
			O	100	200	
			Y	160	320	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$			1.5	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=200\text{mA}$	20			MHz

无锡华晶微电子股份有限公司

地址:江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话:(0510)5807228-2268、2299 传真:(0510)5800360

3 特性曲线

